Перенос энергии $Ce^{3+} \rightarrow Eu^{2+}$ в соединении $CaGa_2S_4$

© Р.Б. Джаббаров¶

Институт физики им. Г.М. Абдуллаева Академии наук Азербайджана, 370143 Баку, Азербайджан

(Получена 2 июня 2001 г. Принята к печати 27 сентября 2001 г.)

Представлены результаты исследования люминесценции $CaGa_2S_4:Eu^{2+}$, $CaGa_2S_4:Ce^{3+}$, $CaGa_2S_4:(Eu^{2+}, Ce^{3+})$. Фотолюминесценция этих соединений обусловлена внутрицентровыми переходами ионов Eu^{2+} и Ce^{3+} . Показано, что в $CaGa_2S_4:(Eu^{2+},Ce^{3+})$ происходит передача энергии от иона Ce^{3+} к иону Eu^{2+} и эффективность передачи энергии составляет 0.43.

Введение примесей редкоземельных элементов (РЗЭ) необходимо для получения большего квантового выхода излучения при оптической и электрической накачке кристаллов CaGa₂S₄, при этом осуществляется эффективная передача энергии возбужденных носителей 4f-электронам. Возбуждение РЗЭ возможно через широкие полосы поглощения матрицы, что в свою очередь снижает порог возбуждения, увеличивая тем самым эффективность выхода люминесценции.

Многообразие излучательных переходов РЗЭ позволяет реализовать как практически любой требуемый цвет свечения, так и лазерную генерацию [1]. Существенная особенность указанных материалов заключается в отсутствии сильного концентрационного тушения (до 7 мол% примеси) для ряда уровней, участвующих в генерации [2,3].

Соединения CaGa₂S₄: Eu²⁺ обладают слабой электролюминесценцией (ЭЛ), однако их добавление к промышленному электролюминофору ZnS:Cu ведет к сильному возрастанию яркости. Достигается 5-кратное увеличение по отношению к яркости промышленного люминофора и 50-кратное по отношению к люминофорам CaGa₂S₄: Eu²⁺. На наш взгляд, резкая неаддитивность связана с увеличением концентрации первичных электронов, разгоняемых для ударного возбуждения центров люминесценции, в результате перепоглощения света промышленного электролюминофора [4].

Явление катодолюминесцении (КЛ) широко используется в настоящее время практически во всех черно-белых и цветных электронно-лучевых трубках [5]. При исследованиях различных объектов КЛ выступает в одном ряду с другими спектроскопическими методами, такими как фотолюминесценция, стримерная люминесценция и т.д. Поскольку механизмы генерации светового излучения в полупроводнике, связанные с рекомбинацией неравновесных носителей заряда, одни и те же для разных способов возбуждения, получаемые результаты будут схожими, однако некоторое различие будет существовать. При КЛ световая эмиссия происходит за счет всех существующих в полупроводнике механизмов излучательной рекомбинации. Изменяя энергию падающих электронов и за счет этого глубину проникновения электронов в кристалл, возможно получить информацию с различной глубины кристалла.

Измерение спектров КЛ проводилось при температуре 300 К по методике, описанной в работе [6]. Образцы возбуждались импульсным пучком электронов с энергией до 40 кэВ при длительности импульсов $6 \cdot 10^{-7}$ с. Число импульсов в секунду — 200, плотность тока в импульсе 0.4–0.2 А/см², глубина проникновения пучка составляет 5-8 мкм. На рис. 1 представлен спектр КЛ кристалла $CaGa_2S_4$: Eu²⁺ при плотности тока $1.5 \cdot 10^{-3}$ A/см². Видно, что в спектре КЛ наблюдается один максимум при энергии фотона $h\nu \approx 2.21$ эВ (длина волны $\lambda \approx 560$ нм). Видно, что спектр практически не имеет тонкой структуры и полоса спектра люминесценции весьма широка. Это связано с эффективным электрон-фононным взаимодействием, имеющим место при излучательных переходах электронов с возбужденных уровней Eu²⁺. Анализ



Рис. 1. Спектр катодолюминесценции кристалла $CaGa_2S_4:Eu^{2+}$ при T = 300 K.

[¶]E-mail: azepl@lan.ab.az



Рис. 2. Спектры излучения (1) и возбуждения фотолюминесценции (2) кристалла CaGa₂S₄: Eu²⁺ при T = 77 K.



Рис. 3. Спектры излучения (1) и возбуждения фотолюминесценции (2) кристалла $CaGa_2S_4: Ce^{3+}$ при T = 300 K.

полученных данных показывает, что наблюдаемый максимум в спектре КЛ обусловлен электронным переходом $4f^65d \rightarrow 4f^7$ ионов Eu^{2+} .

Катодолюминесценция в соединениях CaGa2S4: Eu²⁺ характеризуется весьма малым временем затухания $(< 5 \cdot 10^{-7} \text{ c})$ и высокой световой отдачей (32–40 лм/Вт). Спектр возбуждения фотолюминесценции (ФЛ) $CaGa_2S_4$: Eu^{2+} представляет собой экстремально широкую полосу, которая перекрывается в широком интервале видимой области со спектром излучения (рис. 2). Наблюдаемый спектр возбуждения объясняется поглощением ионов Eu²⁺, так как неактивированное соединение CaGa₂S₄ в этой области спектра не поглощает. Спектр излучения представляет собой узкую полосу с максимумом при $hv = 2.21 \, \text{эВ}$ и полушириной 0.23 эВ при 300 К. Положение максимума излучения кристаллов CaGa₂S₄: Eu²⁺ зависит от концентрации активатора в соединении. Квантовая эффективность излучения (η) при возбуждении с энергией 2.81 эВ составляет 30% [7]. Большая величина η и положение максимума hv = 2.21 эВ делают этот фосфор весьма интересным с практической точки зрения.

3

Высокая конкурентоспособность данного соединения по отношению к промышленным фосфорам обусловлена, кроме того, его высокой адгезией, стабильностью и т.д. Малая величина времени затухания (400 нс) открывает перспективы для применения этих фосфоров при изготовлении флюоресцирующих под действием электронных пучков экранов телевизионных трубок.

На рис. З представлены спектры возбуждения ФЛ и излучения кристаллов $CaGa_2S_4:Ce^{3+}$. Спектр возбуждения состоит из коротковолнового 3.45 эВ (359 нм) и длинноволнового 2.9 эВ (427 нм) пиков. Неактивированный фосфор не обладает активным поглощением вблизи длинноволнового пика, в то время как активированный Ce^{3+} кристалл сильно поглощает в этой области. При 3.45 эВ наблюдается активированными фосфорами. Можно считать, что если в длинноволновой области (2.9 эВ) поглощение происходит на ионах Ce^{3+} , то в коротковолновой оно осуществляется матрицей люминесцентного вещества.

Спектр излучения состоит из двух полос с максимумами при 2.65 эВ (467 нм) и 2.4 эВ (516 нм). При изменении температуры в интервале T = 77-150 К положение максимумов не изменяется, а дальнейшее повышение температуры изменяет интенсивности пиков таким образом, что интегральная интенсивность остается примерно постоянной. При этом полосы излучения обусловлены электронными переходами $5d \rightarrow {}^2F_{5/2}$ и $5d \rightarrow {}^2F_{7/2}$ соответственно.

В случае, если в системе содержится более одного РЗЭ, могут возникнуть неаддитивные эффекты, являющиеся результатом их взаимодействия. Вследствие перестройки системы энергетических уровней взаимодействие может проявляться в изменении спектров поглощения и излучения, длительности возбужденного состояния, вероятности энергетических переходов и ряда других свойств. При больших концентрациях или в случае отклонения от статистического распределения ионов РЗЭ в решетке кристалла наблюдаются другие признаки взаимодействия, такие как смещение линий и перераспределение энергии в них, появление новых линий и исчезновение старых. В одной из развивающихся в данном направлении теорий [8-11] основное внимание уделяется вопросу сенсибилизированной люминесценции, при которой имеет место переход энергии с разрешенного уровня сенсибилизатора на запрещенный уровень активатора.

Сильное перекрытие спектра возбуждения Eu^{2+} и излучения Ce^{3+} может служить причиной передачи энергии от Ce^{3+} к Eu^{2+} , и поэтому нам было интересно исследовать ФЛ в CaGa₂S₄: (Eu²⁺,Ce³⁺). Возбуждение проводили импульсным N₂-лазером (длина волны $\lambda = 337$ нм, длительность импульсов 10 нс, частота следования 1000 Гц, плотность мощности 20 кВт/см²).

На рис. 4 представлены спектры $\Phi \Pi$ CaGa₂S₄: (Eu²⁺, Ce³⁺) при 77 и 300 К. Видно, что спектр состоит из одного максимума при 2.21 эВ

(560 нм) с полушириной 0.08 и 0.10 эВ при 77 и 300 К соответственно. Максимумы, характерные для спектра $CaGa_2S_4:Ce^{3+}$, в этом случае не обнаруживаются.

Как показывает теория [12], резонансная передача энергии возникает, когда интеграл перекрытия не равен нулю, т. е.

$$\int_{0}^{\infty} \left(\frac{\bar{\nu}}{\nu}\right)^{4} I(\nu) \, \alpha(\nu) \, d\nu \neq 0, \tag{1}$$

где $\bar{\nu}$ — средняя частота в области перекрытия спектров излучения и поглощения, $\alpha(\nu)$ — коэффициент поглощения, отнесенный к одному центру, $I(\nu)$ — спектр излучения, приведенный к единице.

При этом вероятность передачи энергии W_{SA} в приближении дипольного взаимодействия центров, находящихся на расстоянии R_{SA} , пропорциональна R_{SA}^{-6} . Таким образом, W_{SA} резко убывает по мере увеличения расстояния между взаимодействующими центрами [11]:

$$W_{SA} = \frac{3\hbar^4 c^4 Q_A}{4\pi K^2 \tau_S} \left[\frac{1}{R_{SA}} \right]^6 \int \frac{f_S(E) f_A(E)}{E^4} dE, \qquad (2)$$

где τ_S — время жизни в сенсибилизаторе при отсутствии активатора, R_{SA} — расстояние между ионами сенсибилизатора и активатора, K — диэлектрическая константа кристалла, E представляет собой передачу энергии,

$$\Omega = \int f_{\mathcal{S}}(E) f_{\mathcal{A}}(E) \frac{dE}{E^4} \tag{3}$$

определяется перекрытием нормированного спектра излучения $\operatorname{Ce}^{3+} f_S(E)$ и спектра поглощения $\operatorname{Eu}^{2+} f_A(E)$.

В большинстве кристаллов, активированных ионами Eu²⁺, первый возбужденный уровень конфигурации $4f^{7}(^{6}P_{J})$, положение которого ~ 27 500 см⁻¹ [13], не обнаруживается в оптических спектрах. Причина заключается в том, что в этой же области расположена группа широких уровней смешанной 4 f⁶5d-конфигурации $({}^{8}H, {}^{8}G, {}^{8}F)$, связанных разрешенными оптическими переходами с основным состоянием ${}^{8}S_{7/2}$. Как отмечалось в работе [14], при уменьшении кристаллического поля уровни ${}^{8}H, {}^{8}G, {}^{8}F$ смещаются в область высоких энергий, создавая тем самым условия, благоприятствующие наблюдению узкополосных f-f-переходов. В электронной оболочке 4f иона Ce^{3+} , защищенной заполненной оболочкой $5s^25p^6$, имеется всего один электрон. Спектр свободного иона Ce^{3+} был изучен в работе [15]. Он определяется в основном тремя термами ${}^{2}F$, ${}^{2}D$ и ²*S*, из которых первый — основной, остальные два возбужденные. Величины энергии возбуждения соответствуют 51 000 и 87 000 см⁻¹. Спин-орбитальное взаимодействие расщепляет термы 2F и 2D на две пары уровней — ${}^2F_{7/2}$, ${}^2F_{5/2}$ и ${}^2D_{5/2}$, ${}^2D_{3/2}$, с интервалами 2250 и 2500 см⁻¹. На возбужденные электроны в конфигурации 5*d* гораздо сильнее влияние кристаллического поля, чем на 4f-электроны, т.е. кристаллическое поле сильно снижает энергетическое положение возбужденных 5d-уровней, в результате чего электрон



Рис. 4. Спектры фотолюминесценции кристалла $CaGa_2S_4$: (Eu²⁺,Ce³⁺) при T = 300 (1) и 77 (2) K.

легко попадает на этот уровень. Взаимодействие центров оказывает заметное влияние и на кинетику спада люминесценции. Время жизни возбужденных уровней при этом составляет 228 нс. Эффективность передачи энергии, вычисляемая по формуле $\eta = 1 - \tau/\tau_0$ [16], составляет 0.43. Здесь τ_0 — наблюдаемое время жизни иона Eu²⁺ при отсутствии Ce³⁺, τ — наблюдаемое время жизни иона Eu²⁺ в возбужденном состоянии при наличии иона Ce³⁺.

Возбужденные уровни Eu²⁺ сильно расщеплены в кристаллическом поле. Отсутствие в спектре CaGa₂S₄: (Eu²⁺, Ce³⁺) линий, присущих CaGa₂S₄: Ce³⁺, может быть следствием безызлучательной передачи энергии этих состояний на возбужденный уровень Eu²⁺. Далее происходит безызлучательный переход на люминесцирующий уровень, и наблюдается переход ($4f^{6}5d \rightarrow 4f^{7}$), сопровождающийся излучением.

Список литературы

- S. Iida, T. Matsumoto, N.T. Mamedov, G. An, Y. Maruyama, A.I. Bairamov, B.G. Tagiev, O.B. Tagiev, R.B. Dzhabbarov. Japan J. Appl. Phys., 36, pt 2, (7A), L857 (1997).
- [2] Б.Г. Тагиев, В.А. Джалилов, Т.А. Гюльмалиев, Г.М. Нифтиев, О.Б. Тагиев, Ф.Б. Аскеров, Б.М. Иззатов, Я.Г. Талыбов. Неорг. матер., 28 (12), 2269 (1992).

- [3] Б.А. Тагиев, М.Г. Шахтахтинский, В.А. Джалилов, Т.А. Гюльмалыев, Б.М. Иззатов, Г.К. Асланов, О.Б. Тагиев, Я.Г. Талыбов. Неорг. матер., 29 (10), 1392 (1993).
- [4] Б.Г. Тагиев, А.Б. Абдуллаев, О.Б. Тагиев, Г.А. Касимова, Ф.Н. Султанов, Б.М. Иззатов, Н.Н. Мусаева, Р.Б. Джаббаров, А.Н. Георгобиани, Л.С. Лепнев, З.П. Илюхина. ЖПС, 62 (3), 145 (1995).
- [5] В.И. Петров. УФН, 166 (8), 859 (1996).
- [6] М.В. Чукичев, Д.М. Сабри, В.И. Соколов, Т.П. Суркова. Опт. и спектр., 68 (1), 200 (1990).
- [7] T. Matsumoto, S. Iida, N.T. Mamedov, G. An, Y. Maruyama, A.I. Bairamov, B.G. Tagiev, O.B. Tagiev, R.B. Dzhabbarov. *11th Int. Conf. on Ternary and Multinary Compounds* (Salford, 1997) p. 1001.
- [8] Y. Tan, C. Shi. J. Phys. Chem. Sol., 60, 1805 (1999).
- [9] M.D. Shinn, W.A. Sibley. Phys. Rev. B, 29 (7), 3834 (1984).
- [10] J.O. Rubio, A.F. Minoz, C. Zaldo, H.S. Murrieta. Sol. St. Commun., 65 (4), 251 (1988).
- [11] R. Capelletti, M. Manfredi, R. Gywinski, J.Z. Damm,
 E. Mugenski, M. Solzi. Phys. Rev. B, 36 (10), 5124 (1987).
- [12] В.М. Агранович, М.М. Галаник. Перенос энергии электронного возбуждения в конденсированных средах (М., 1978).
- [13] П.П. Феофилов. В сб.: Спектроскопия кристаллов (М., 1966) с. 87.
- [14] G. Blasse, Phys. St. Sol. (b), 55, k131 (1973).
- [15] Н.В. Старостин, П.Ф. Груздев, В.А. Ганин, Т.Е. Чеботарева. Опт. и спектр., 35 (3), 476 (1973).
- [16] R.J. Ralph, B.L. Clyde, J.W. Marvin. J. Appl. Phys., 47 (5), 2020 (1976).

Редактор Л.В. Шаронова

The Ce³⁺ \rightarrow Eu²⁺ energy transfer in CaGa₂S₄ compound

R.B. Jabbarov

Institute of Physics, Azerbaijan Academy of Sciences, 370143 Baku, Azerbaijan

Abstract We present results on investigation of the luminescense of $CaGa_2S_4:Eu^{2+}$, $CaGa_2S_4:Ce^{3+}$, $CaGa_2S_4:(Eu^{2+},Ce^{3+})$. The photoluminescence in $CaGa_2S_4:(Eu^{2+},Ce^{3+})$ occurs due to intracentre transitions of Eu^{2+} and Ce^{3+} ions. The energy transfer takes place from Ce^{3+} to Eu^{2+} the efficiency of the energy transfer being equal to 0.43.